

Weibo Tongxin Shebei Weihu Jingyan

# 微波通信设备维护经验

第一辑

人民邮电出版社

# 微波通信设备维护经验

第一辑

人民邮电出版社

## 内 容 提 要

本书是微波通信设备维护经验及技术革新的选辑。主要选自1974年及1975年《电信技术》杂志上的文章。内容包括电路分析、维护经验、技术革新、技术知识几个部分。可供从事微波设备维护工作的工人及技术人员参考。

## 微波通信设备维护经验

### 第一辑

\*

人民邮电出版社编辑、出版  
北京东长安街27号  
北京印刷一厂印刷  
新华书店北京发行所发行  
各地新华书店经售  
限 国 内 发 行

\*

开本：787×1092 1/32                    1977年5月第一版  
印张：10 页数：160                    1977年5月北京第一次印刷  
字数：227千字                            印数：1—9,000册  
统一书号：15045·总2142·无624  
定价：0.80元

## 出版说明

伟大的无产阶级文化大革命推动了电信事业的大发展。通信设备成倍增长。广大电信人员遵照伟大领袖毛主席“抓革命，促生产，促工作，促战备”的教导，认真学习无产阶级专政理论，以阶级斗争为纲，以高度的革命热情，加强设备维护，大搞技术革新，提高通信质量，积累了许多好经验。

为了使这些从实践中取得的经验得到交流，我们将陆续出版各类电信设备的维护经验选辑。

本书是微波通信设备的维护经验选辑，内容选自 1974 年至 1975 年出版的《电信技术》杂志，供同志们参考。

# 目 录

## 第一部分 电路分析

- 一、960路微波振荡源 ..... ( 1 )
- 二、行波管浅谈 ..... ( 21 )
- 三、70兆赫中频放大器 ..... ( 33 )
- 四、微波混频器 ..... ( 46 )
- 五、变容二极管频率调制器 ..... ( 58 )
- 六、双失谐回路鉴频器 ..... ( 65 )
- 七、波道倒换机部分单元电路介绍 ..... ( 76 )
- 八、波道倒换机倒换程序简介 ..... ( 84 )
- 九、波道倒换机各灯键的性能和作用 ..... ( 88 )
- 十、自动频率微调 ..... ( 100 )

## 第二部分 维护经验

- 一、微波振荡源障碍处理经验 ..... ( 115 )
- 二、维护微波振荡源的点滴体会 ..... ( 119 )
- 三、微波收发信机的不停机检修 ..... ( 123 )
- 四、行波管障碍处理的几点措施 ..... ( 131 )
- 五、延长行波管使用年限的经验 ..... ( 134 )
- 六、行波管跳闸障碍的排除几例 ..... ( 142 )
- 七、延长行波管使用寿命的点滴经验 ..... ( 146 )
- 八、处理行波管聚焦反常的体会 ..... ( 149 )
- 九、螺旋线电源盘常见障碍与排除 ..... ( 153 )

十、微波联络机故障分析	(157)
十一、联络机监听盘的维护	(166)
十二、波道倒换机部分故障检查	(169)
十三、600路高频机架整治经验点滴	(174)
十四、监测微调盘“X”塞孔电流小经验	(177)
十五、960路载波机超群设备的维护	(179)
十六、电视传输中常见的几种干扰	(184)
十七、处理电视干扰的一点体会	(188)
十八、微波通信电路的稳定性	
微波传输电平稳定性	(191)
十九、微波工作频率稳定性	(201)
二十、测试电话通道噪声的点滴体会	(211)

### 第三部分 技术革新

一、一个使用方便的公务控制台	(218)
二、改装915型电视监测机兼作电路监听器	(222)
三、超群发信监测指示器	(223)
四、微道通道音频汇接放大器	(227)
五、联络机通话盘小改革	(230)
六、输出变压器用RG代换	(230)

### 第四部分 技术知识

一、电视信号的微波中继传输	(232)
二、微波收发信机技术指标及电平图	(238)
三、微波通信中的失真与噪声	(248)
四、微波注入锁相振荡源	(261)
五、简谈卫星通信的特点	(277)

六、速调管.....	(285)
七、变容二极管.....	(290)
八、阶跃恢复二极管.....	(298)
九、肖特基势垒二极管.....	(302)
十、什么是限幅系数.....	(309)

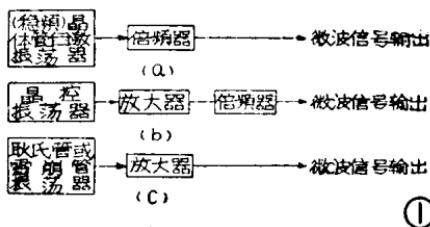
# 第一部分 电路分析

## 一、960 路微波振荡源

### 概述

振荡源是微波收发信机的关键部件之一。这篇文章介绍的微波振荡源是一种使用晶体三极管、变容管、阶跃管、雪崩管等这些固体器件组成的微波振荡源，所以又叫做固态源。它的作用和外差式收音机的本地振荡器相似。主要作用就是给混频器提供本振信号。

振荡源有好多种，分类方法也不一样。按照所用振荡元件可分成三种基本形式(见图1)，晶体管自激振荡倍频式(图 1 a)、晶控主振放大倍频式(图 1 b)以及耿氏或雪崩二极管直接振荡放大式(图 1 c)。



我国多路微波设备常用的三种振荡源有：倍频链振荡源、环路锁相振荡源和注入锁相振荡源，这三种都属于第二类形



式。本文只从使用维护需要，重点介绍图 2 所示的  $1 \times 4 \times 10$  晶控主振放大倍频振荡源。

### 振荡源工作原理

为了叙述方便，把高频架（高端）发信用的  $1 \times 4 \times 10$  晶控主振放大倍频振荡源，作为我们的分析对象。电路方框图见图 2。

从方框图看出，第一级是晶控振荡器。首先由它产生一个十分稳定的 100 兆赫振荡，大约在 75 欧负载上可输出 20 毫瓦的功率。这个振荡十分稳定，是因为用了压电元件——石英晶体。为了保持振荡的稳定性，避免受负载变化的影响，在第二级用了 3 分贝电阻衰耗器作隔离。然后，100 兆赫 10 毫瓦信号被送入三级功率放大器，放大到 1 瓦以上的功率。一、二级功率放大器间的 3 分贝衰耗器，除起隔离作用外，还可以使功率放大器（二）的晶体管有一个合适的激励电平。需要三级功率放大器，是因为末端要求得到 4000 兆赫 30 毫瓦的微波信号。这就是说，后面的电路，还得把 100 兆赫振荡信号的频率升高 40 倍；一般地，一个信号的频率被升高，必须要损失功率才能做到（用二极管倍频情况）。这样，100 兆赫 1 瓦多的信号在经过变容管 4 倍频器后，便得到 400 兆赫 500 毫瓦左右的信号，然后送入同轴腔 10 倍频器。由装在腔内的阶跃恢复二极管产生输入频率的各次谐波，再由输出腔和波导滤波器选出需要的第 10 次谐波，最后在单向器后面得到 4000 兆赫大于 30 毫瓦的微波。

信号。

装在变容管 4 倍频器与同轴腔 10 倍频器之间的 400 兆赫集中参数环行器，第三臂有匹配用负载电阻，第一臂和第二臂当作一个单向器，有反向隔离 20 分贝的作用。

波导型场移式单向器的作用是：前一个可使同轴腔 10 倍频器工作稳定，后一个使高频架上的发信混频器调整方便。它们共同保持波导滤波器特性不受前后级器件的影响。

为了防止外界杂散电磁场影响，振荡源电路部分装在铝质金属盒内，屏蔽良好并防止振荡源功率泄漏。

### 振荡源主要技术指标及说明

#### (1) 功率和功率稳定性

高频架发信混频器要求振荡源功率大于 30 毫瓦，这是根据混频效率而定的。在  $0^{\circ}\sim 40^{\circ}\text{C}$  温度范围内，允许振荡源功率下降百分之三十，因为这个变化范围，仍旧可使行波管放大器有 5 瓦的发射功率输出。振荡源功率常因结构不牢存在着潜在的不稳定因素，应设法排除。

#### (2) 频率和频率稳定度

振荡源在 3800~4200 兆赫范围内提供单一频率输出。这个频率允许偏差不超过 217 千赫，包括晶体本身的不准确度和晶控振荡器在  $0^{\circ}\sim 42^{\circ}\text{C}$  温度范围内的长期频率漂移。必须注意，由于调整不当，会使晶体的标称频率偏移近 1 千赫，经 40 次倍频后带来近 40 千赫的附加频率误差，可见调整方法是否正确，会影响频率稳定度，因此应仔细调整。

#### (3) 噪声和杂波输出

微波多路通信对振荡源的噪声是很“敏感”的。因为在混频过程中，振荡源噪声会转移到群频上去。在 960 路微波收发系统

中，要求每部振荡源噪声小于 10 微微瓦（加权不计重）。这个要求一般不难达到，只要选用  $f_T$  较高的管子，多设几级滤波器（尤其在 4 倍频器后面），注意调整方法，把整个振荡源选择性曲线调得越窄越好。

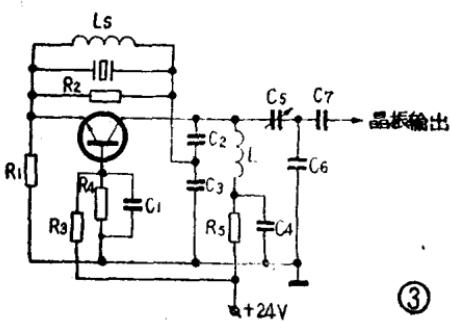
由振荡源引入到群频频谱内高于热噪声的杂波干扰，来源于晶体的多频性，以及末级功放管和变容管的非线性，这就要求严格控制各级电路的谐波抑制度。

#### (4) 稳定性

这是振荡源最重要的指标，除上已叙述过的两点外，它的主要含义包括下面几点：第一，电路不能出现寄生振荡或接近自激。第二，在长期使用过程中，不应出现功率消失，或各项指标下降到影响整机正常通信的程度。第三，经常期搁置不用的振荡源，通电后不需要调整，应能达到要求指标。第四，在规定运输条件下，振荡源经允许的震动冲击后，应能正常工作。

为了达到这些要求，电路间应有良好的屏蔽和去耦，注意各级电路匹配和调整方法，必须讲究生产工艺，严格挑选管子及各元件；装入振荡源的管子应预先老化。调整好的振荡源进行轻敲轻打是简单有效的检查方法，不可忽视。因为振荡源的特点是频率高、功率大，由机械结构形成的分布电参量均被包

括在振荡源各级电路内，它们的不稳定，往往造成振荡源回路失谐，引起功率下降及其他毛病。



③

### 单元电路介绍

#### (1) 晶控振荡器

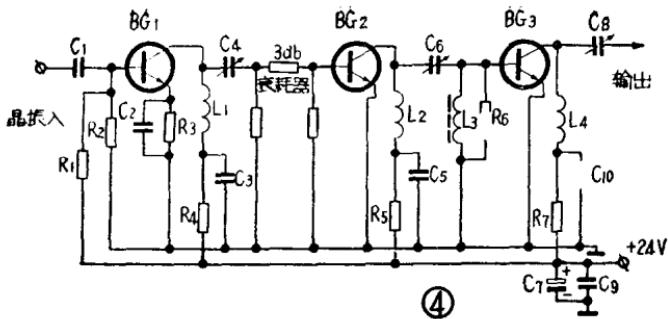
电路如图 3 所示。这是一个电容三端式晶控稳频振荡器。频率稳定度较高，在 $0^{\circ}\sim42^{\circ}\text{C}$ 温升范围内，频率稳定度能做到 $\frac{\Delta f}{f} \leq 2 \times 10^{-5}$ ，而不用采取特殊措施。电阻 $R_1$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 和+24伏电源组成偏置电路； $e\sim b$ 间正向偏压由+24伏电源经电阻分压器 $R_3$ 、 $R_4$ 供给， $c\sim e$ 间反向偏压由电源经 $R_5$ 馈送。 $R_1$ 、 $R_4$ 是直流负反馈电阻。晶体管工作点选得较低，以防止工作到饱和区，因而振荡稳定。起振前晶体管工作于甲乙类状态，振荡时工作在丙类。

由 $L$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 、 $C_5$ 、 $C_6$ 和晶体管输出电容构成的振荡回路应调整到晶体串联谐振频率上，主要靠调整 $C_5$ 得到。振荡功率大部分经耦合电容 $C_7$ 送往下级电路放大，一部分按 $\frac{C_2}{C_2+C_3}$ 分压比，由 $C_3$ 取出经过晶体反馈到晶体管射极。

反馈回路内的晶体是振荡器频率稳定度较高的主要原因。在谐振频率时，晶体相当于一个80欧左右的电阻，但是制造不良的晶体，如果等效电阻 $R_g$ 大于200欧，会造成振荡弱，甚至停振。电路中 $L_s$ 和 $R_2$ 是用来防止寄生振荡的。 $L_s$ 和晶体支架电容（约7~8微微法）并联谐振在工作频率上，使得工作频率附近的寄生频率不能到达晶体管射极。 $R_2$ 是给通过电抗元件到达晶体管输入端的寄生频率产生附加相移，所以可抑制寄生振荡。 $C_1$ 、 $C_4$ 是防止交流进入电源的旁路电容器。

## (2) 功率放大器

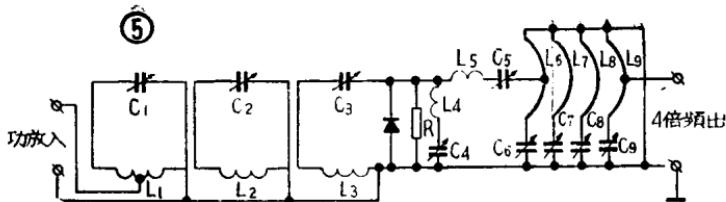
电路见图4。三级功率放大器总增益约24分贝，第一级10分贝，第二级9分贝，末级5分贝全部采用共发电路。第一级功放晶体管工作于甲类，是考虑到晶控振荡器送来的激励信号较小，用共发电路可得到较高的功率增益。另外，还为了和前面电阻衰耗器固定75欧阻抗相适应。这一级没有设计专用



的输入匹配电路，而是由晶振级电容器  $C_7$  作为匹配调整。本级输出匹配电路部分由  $L_1$  和管子输出电容组成的并联谐振电路构成，并由  $C_4$  和 3 分贝电阻衰耗器作为耦合匹配元件。第二级功放晶体管是丙类工作。它的输出匹配电路也是一个并联谐振电路，由  $L_2$  和管子的输出电容以及  $C_6$  和末级管子的输入阻抗组成。末级晶体管也是丙类工作。输出匹配电路由  $L_4$  和管子输出电容以及  $C_8$  和下级带通滤波器的反射电抗组成的并联谐振电路构成。电路中其他元件作用如下： $C_1$  耦合电容， $R_1$ 、 $R_2$  供给  $BG_1$  正向偏压， $R_3$  直流负反馈电阻， $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_7$  是晶体管保护电阻；某种原因使集电极电流突然增加时，流过它们产生很大压降，使加到  $c \sim e$  间的集电极电压减小，因而降低了集电极损耗功率。同时  $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_7$  分别与  $C_3$ 、 $C_5$ 、 $C_{10}$  相配合还起各级退耦作用防止功放自激。 $C_2$ 、 $C_3$ 、 $C_5$ 、 $C_{10}$  是旁路电容器， $C_7$ 、 $C_9$  是电源去耦电容， $C_7$  对减少广播干扰效果明显。 $L_3$  给  $BG_3$  基极提供直流通路，与  $L_3$  并联的  $R_6$ ，是用来降低  $L_3$  的  $Q$  值，可防止寄生振荡。

### (3) 变容管 4 倍频器

电路见图 5。倍频器中变容管与输入回路和输出回路并联，



所以属于并联型倍频器电路。这种电路的主要特点是输入阻抗和输出阻抗低。另外由于变容管有一端接地，所以散热方便。倍频器的工作原理是利用变容管的非线性电容变化。具体地说，如果输入回路把一个正弦信号电压加在二极管两端时，这时二极管的电容也随着输入信号而发生变化。因为电容变化与外加信号电压不是线性关系，结果流过二极管的电流就不再是正弦形状，这个非正弦的电流包含许多高次谐波，只要利用输出回路，把需要的某次谐波选出，就可构成一个倍频器。

图 5 电路图内， $L_1, C_1, L_2, C_2$  组成匹配耦合电路。它是一个双回路调谐互感耦合带通滤波器。作用是把功率放大器输入的 100 兆赫信号滤除谐波和噪声后，送到倍频器输入回路  $L_3, C_3$ 。 $L_3, C_3$  和二极管对输入频率的等效电容串联谐振在输入频率上。变容管产生的高次谐波，由输出回路  $L_5, C_5$  选出需要的 400 兆赫频率。 $L_5, C_5$  和变容管对输出频率 400 兆赫的等效电容也要串联谐振在输出频率上。它可以防止其他谐波输出，并防止基波短路。由  $L_6, C_6, L_7, C_7, L_8, C_8, L_9, C_9$  组成输出匹配耦合用带通滤波器，此滤波器的 3 分贝带宽约 6~8 兆赫，它对滤除无用谐波效果明显。这个滤波器结构上状似“排骨”，故叫做“排骨”形滤波器，实际上是终端加载的梳状滤波器的变形。

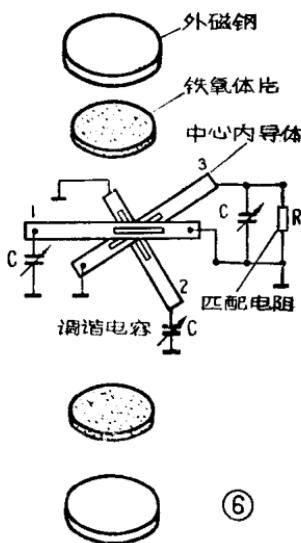
每根“排骨”对 400 兆赫来说都是缩短的  $\frac{1}{4}$  波长短路线。R 是自

偏压电阻。这个偏压是由变容管所产生的失真波形中的直流分量形成的。 $R$  的大小可改变变容管自给偏压的大小。 $L_4, C_4$  构成空闲电路，对二次谐波串联谐振（给二次谐波一个通路）。这个二次谐波电流经过二极管时，又产生它的二倍频，于是得到需要的 4 倍频率。空闲电流的回路是  $L_4, C_4$  和二极管。由于接入空闲回路，可使 400 兆赫输出功率增加，因而提高了倍频器的效率。图 5 电路也可加接三次谐波空闲回路，使得三次谐波电流与基波电流在二极管内混频，产生  $100 + 3 \times 100 = 400$  兆赫的和频，以提高倍频效率。目前 4 倍频器的效率可达到 40% 左右。

#### (4) 400 兆赫集中参数环行器

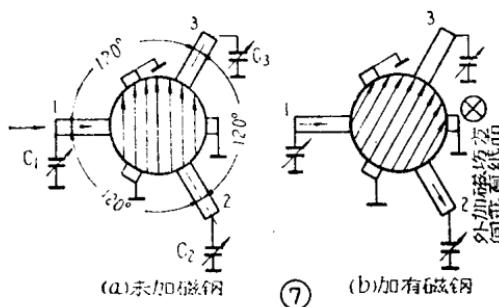
这是 Y 形三端环行器的一种。结构示意图如图 6 所示（图中拆开画了）。中心导体和与它相接的调谐电容器组成谐振电路，起两个作用：一是谐振时呈纯电阻，以便与外电路匹配；

二是使铁氧体片得到磁感应通量。铁氧体片和外磁钢一起形成旋转磁场。匹配电阻的作用是保持 1、2、3 端阻抗对称性；因为 1、2 端接有外电路阻抗，这些外电路阻抗都等于匹配电阻。



环行器工作原理可用图 7 说明。从图 7 (a) 看出，400 兆赫信号从 1 端进去，由电容器  $C_1$  调到谐振。回路 1 中的电流在铁氧体内感应的磁通方向如箭头所示(瞬时)。这时，感应磁通方向与 1 端中心导体片相交  $90^\circ$ 。我们的目的是从 2

端取出信号，而不希望在 3 端出现信号。这只要让感应磁通方向旋转  $30^\circ$  就可达到目的。因为三个中心导体片是对称分布的，互成  $120^\circ$ 。铁氧体内感应磁通旋转  $30^\circ$  后，便与 2 端中心导体片相交某一角度，结果 2 端产生感应电流，有信号输出；而与 3 端中心导体片平行，3 回路不切割磁力线，所以得不到感应电流，如图 7 (b) 所示。

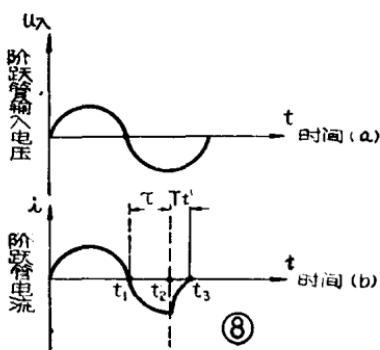


怎样才能让感应磁通旋转  $30^\circ$  呢？只要在铁氧体片上加一个适当的恒定磁场即可。

400 兆赫集中参数环行器，在振荡源中作为隔离器使用，使 4 倍频器和 10 倍频器不互相影响。它的 1 端是输入端，2 端是输出端。使用时只要调整 1、2 端调谐电容器，对输入频率谐振即可。第三端调谐电容器对反向隔离比影响很大，已由工厂生产时调好封漆，不需要再调。第三端接的匹配电阻不需要随意挪动或拆下换用，否则环行器指标变坏。这种环行器的正向衰耗小于 1 分贝，反向隔离比大于 20 分贝。

### (5) 同轴腔 10 倍频器

同轴腔 10 倍频器是由倍频器使用同轴线式谐振腔得名的。这种腔体有一个内导体和一个外导体。电流沿着内导体的



外表面和外导体的内表面传播和同轴线的情况完全一样。实际上倍频作用是由装在腔内的阶跃管产生的。同轴腔相当一个振荡回路，在这里只是起到滤波器的作用。因此 10 倍频器的工作原理，主要就是阶跃管为什么能够倍频的原理。下面用

图 8 说明这个问题。

图 8 (a) 表示加到阶跃管的输入电压随时间按正弦规律变化；图 8 (b) 表示阶跃管内电流随时间变化情况。从图中看出，输入电压正半周时，阶跃管导电，产生正向电流。从  $0 \rightarrow t_1$  的正向电流变化规律和输入电压正半周相同。并且电流曲线和时间轴围起来的曲面积代表阶跃管正向储存的电荷；由于制造阶跃管时有意使得阶跃管内载流子寿命延长，所以正向储存的电荷是很多的。这时阶跃管相当一个大电容。当输入电压负半周时，阶跃管并不马上截止，而是存在有很大的反向电流，这个电流分两部分来分析。一部分从  $t_1 \sim t_2$ ，按正弦规律变化。这是因为正向储存的电荷在反向输入电压作用下，通过外电路放电，由于放电速度一样，所以这部分电流变化也呈正弦特性。另一部分反向电流是  $t_2 \sim t_3$ 。它的变化十分迅速，不呈正弦特性。这是因为在时间  $t_2$  时，正向储存电荷已全部放完，反向电流应立即为零，只是因为阶跃管存在反向电容，所以放电才成为图 8 (b) 所示的样子。要指出的是，图 8 表示的阶跃管内电流的变化是假设阶跃管反向电阻是无限大的情况。

从上述情况看到，由于阶跃管内发生  $t_2 \sim t_3$  这段反向电流